

CVD-SiC —高純度バルクSiC—

CVD-SiC

CVD-SiCは独自の気相成長法(CVD法)によって製造された高純度バルクSiCです。SiCコーティング品におけるピンホールや剥離の問題が起こること無く、また電気抵抗値の調整が可能で、高抵抗、低抵抗2種類の供給が可能で用途に応じて使い分けられております。

特 徴

- 高純度99.9995%
- 耐プラズマ性
- ダスト低減のための表面処理可能
- 放電加工可能
- 酸素、アンモニア雰囲気でも使用可能
- 高熱伝導率
- 高耐熱性



代表物性値

密度	g/cm ³		3.21
硬度(ビッカース)	—		2500
曲げ強度	M Pa	RT	415
		1400°C	575
破壊靱性	MPa・m ^{1/2}		2.94
熱伝導率	W/m・K		300
熱膨張率	—	RT	2.2×10E-6
		RT to1000°C	4.0×10E-6
電気伝導率	Ω・cm	高抵抗	> 1
		低抵抗	< 1
比熱	J/kg・K		640



不純物測定値 (GDMS)

Fe	Ni	Cu	Al	Ca	Na	Cr
<40	<13	<16	9.1	<5.8	30	—
K	Ti	V	B	Mn	Zn	W
<9.4	<4.2	<1.4	290	<3.9	<36	<12

(Unit : ppb)

